تولید، مشخصهیابی ساختاری و ارزیابی خواص مغناطیسی پوششهای نانوساختار آهن-کبالت- تنگستن تهیه شده به روش آبکاری الکتریکی

زهرا غافری^{۲,۱}۴, شهریار شرفی^۳, محمد ابراهیم بحرالعلوم[†]

چکیدہ

در این تحقیق پوششهای نانوساختار آهن-کبالت-تنگستن به روش آبکاری جریان مستقیم بر روی زیر لایه مسی حاصل شد. نتایج نشان داد که چگالی جریان پوششدهی و نیز ترکیب شیمیایی محلول بر خواص مغناطیسی و ساختاری اثرگذار است. مورفولوژی پوششهای بدست آمده از دو حمام آبکاری متفاوت بوده و با افزایش چگالی جریان آبکاری مقدار فاز fcc موجود در ساختار دو فازی fcc+bcc کاهش یافت. مشاهده شد که پارامترهای آبکاری تاثیر چشمگیری بر روی تغییرات اندازه دانه نداشته و اندازه دانه پوششها کمتر از ۲۰ نانومتر گزارش شد. با افزایش چگالی جریان، رسوب دهی تحت کنترل نفوذ درآمده و مقدار تنگستن رسوب کرده و در نتیجه میکروسختی پوششها کاهش یافت. با توجه به نتایج حاصل از پراش پرتو ایکس (XRD) و نیز مغناطش سنج نمونه لرزان (VSM) میتوان تغییرات گسترده در مقدار وادارندگی را به تغییرات فازی در این پوششها مربوط دانست.

واژه های کلیدی: خاصیت مغناطیسی، آبکاری الکتریکی، نانوساختار، آهن-کبالت-تنگستن.

^{ٔ -} دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

^{ً-} انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان

^۳ – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

^{ٔ-} استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

^{*-}نویسنده مسئول مقاله:ghaferi_z@yahoo.com

پیشگفتار

آلیاژهای دوتایی هم گروه آهن دارای استحکام و سختی بالا، خاصیت مغناطیسی و نیز مقاومت به خوردگی خوبی هستند [۱]. این آلیاژها در صنایع پیشرفته نظیر فناوری های فضایی، ساخت موشک، قطعات و حافظه های مغناطیسی مورد استفاده قرار می گیرند [1]. برای جلوگیری از اتلاف انرژی و اثرات مخرب ناشی از گرمایش قطعه، لازم است که در کاربرد اخیر ماده دارای حداکثر مغناطش اشباع و حداقل وادارندگی باشد [۲، ۳]. در این ميان آلياژهاي آهن-كبالت داراي بالاترين مغناطش اشباع هستند که میتوانند جهت ساخت حافظههای مغناطیسی مورد استفاده قرار گیرند. برخلاف مزایای ذکر شده آلیاژ مذکور دارای میدان وادارندگی نسبتاً بالایی است که کاربرد آن را در این مورد محدودتر میکند. برای حل این مشکل راههای گوناگونی پیشنهاد شده است، افزودن عناصر آلیاژی نظیر نیکل یا مس و کاهش اندازه دانه در حد نانومتری می تواند مقدار وادارندگی را تا حد امکان کاهش دهد [۲،۴].

فلزات و آلیاژهای نانوساختار به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر بفردی که دارند در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد به روشهای متعددی ساخته میشوند که از بین آنها روش آبکاری الکتریکی به دلیل آسان تر و ارزان تر بودن نسبت به سایر روشها ترجیح داده میشود [۶، ۵، ۲]. تا کنون پژوهشهای زیادی بر روی خواص مغناطیسی این دسته از آلیاژها صورت گرفته است. کوزا^۱ و همکارانش به بررسی اثر حضور میدان مغناطیسی یکنواخت بر خاصیت مغناطیسی پوششهای آلیاژی کبالت- آهن پرداختند [۸، ۲]. اثر پوشش دهی بر خواص مغناطیسی این دسته از آلیاژها مورد ارزیابی قرار گرفته است [۱۰–۲، ۲].

برای ایجاد حافظههای مغناطیسی داشتن خاصیت مغناطیسی مطلوب، سختی و نیز مقاومت به سایش مناسب ضروری است [۱۲]. بنابراین هدف از این مطالعه تولید پوششهای نانوساختار آهن-کبالت-تنگستن به روش آبکاری الکتریکی و بررسی اثر چگالی جریان و

ترکیب شیمیایی محلول بر خواص مغناطیسی و ساختاری این پوششها است.

مواد و روشها

در این پژوهش از قطعه مسی با مساحت ۱ سانتیمتر مربع و خلوص ٪۹۹/۹۸ به عنوان زیر لایه استفاده شد. نمونهها توسط لحيم به سيم مسى متصل شده و تا سنباده ۳۰۰۰ به وسیله پولیش مکانیکی سائیده شدند. جدول ۱ ترکیب شیمیایی حمام آبکاری را نشان میدهد که در آن برای ساخت محلول از مواد اولیه ساخت شرکت مرک استفاده شد. با استفاده از اسید سولفوریک و هیدروکسید سدیم رقیق، اسیدیته محلول بر روی ۵ تنظیم شد. پوششدهی به روش جریان مستقیم و در دمای اتاق با استفاده از دستگاه کولومتر دیجیتالی ساخت شرکت بهپژوه (BHP 2056) انجام شد. برای این منظور از فولاد زنگنزن ۴۳۰ به عنوان آند و نمونه مسی به عنوان کاتد استفاده شد. در این حالت مقدار بار الکتریکی عبور کرده ثابت و برابر ۵۰ کولن انتخاب شد. این امر سبب ايجاد پوشش هايي با ضخامت تقريباً يكنواخت ١٨ ميكرون در تمامی حالات گردید. چگالی جریانهای اعمالی نیز در محدوده ۵۰–۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع انتخاب شدند. بازده جریان ٔ در هر دو حمام و در چگالی جریان های مختلف با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد[١٣]:

$$CE = \frac{w \times F}{I \times t} \sum \frac{C_i \times n_i}{M_i} \times 100 \tag{1}$$

در این رابطه CE بازده جریان، W وزن رسوب ایجاد شده (گرم)، t زمان رسوب گذاری (ثانیه)، I جریان آبکاری (آمپر)، C_i و n_i به ترتیب کسر وزنی هر یک از عناصر رسوب کرده در آلیاژ و ظرفیت آنها، M_i وزن اتمی عناصر رسوب کرده (گرم بر مول) و F ثابت فارادی (۹۶۴۸۵ کولن بر مول) هستند.

²- Current efficiency (CE)

غلظت (مولار)		
محلول ۲	محلول ۱	ىر ىيب سيميايى
• /٢	•/٢	سولفات كبالت
•/\۶	•/\۶	سولفات آهن
• / • ٣	• /• ١	تنگستات سدیم
• /Y	•/Y	سولفات سديم
•/•۵	•/•۵	اسيد آسكوربيك
•/۴	٠/۴	اسيد بوريک
۰ /٣	٠/٣	سيترات سديم

جدول ۱- ترکیب شیمیایی حمامهای مورد استفاده در آبکاری

۸/۰×۵/۰ سانتیمتر مربع صورت گرفت. در این حالت میدان ۳۰۰۰ اورستد به موازات سطح نمونهها اعمال شد. به منظور بررسی میکروسختی پوششها از دستگاه میکروسختی سنج Leitz (بار اعمالی ۱۰۰ گرم و زمان اعمال بار ۱۰ ثانیه) استفاده شد. برای اطمینان از نتایج ارائه شده، هر آزمون ۴ بار تکرار و نتایج به صورت میانگین گزارش شد.

نتایج و بحث

مورفولوژی و ترکیب شیمیایی

بازده جریان مربوط به دو حمام آبکاری (۰/۰۱ و ۰/۰۳ مولار یون تنگستات)، در چگالی جریانهای گوناگون محاسبه و نتایج در شکل ۱ نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده، راندمان آبکاری در محلول ۰/۰۱ مولار یون تنگستات بالاتر از حمام دیگر بوده و در بیشترین حالت به ۳۵ درصد میرسد. از آنجاکه با افزایش چگالی جریان شرایط برای آزاد سازی هیدروژن مناسبتر است[۱۶]؛ بنابراین با افزایش چگالی جریان بازده کاهش مییابد. جهت تعیین فازهای موجود در پوشش، از دستگاه پراش پرتو ایکس Philips X'pert با آند مسی و طول موج ۱/۵۴۰۵۶ آنگستروم استفاده شد. اندازه دانه پوششها با استفاده از رابطه شرر (رابطه ۲) و محاسبه مقدار عرض پیک (۱۱۰) در نیمه ارتفاع آن محاسبه شد [۱۴]:

 $d=0.9 \lambda/\beta \cos\theta$ (7)

در این رابطه λ ، β و θ به ترتیب اندازه دانه، طول موج اشعه ایکس، پهنای پیک در نیمه ارتفاع و زاویه پراش هستند. برای این کار از نرم افزار سیگما پلات ۱۲ و معادله گوسین چهار پارامتری برای برازش منحنی استفاده شد. قبل از محاسبه اندازه دانهها بایستی خطای مربوط به پهن شدگی پیکها در دستگاه با استفاده از محاسبه عرض استفاده از روش گوسین- کوئچی انجام شد[۱۵]. پیکها با یک قرص سیلیکون حذف شود. این کار با استفاده از روش گوسین- کوئچی انجام شد[۱۵]. مایکترونی روبشی (SEM) مدل1400 1400 و ترکیب شیمیایی آنها توسط آنالیزور متصل به دستگاه فوق شیمیایی آنها توسط آنالیزور متصل به دستگاه فوق (EDS) مشخص شد. برای ارزیابی رفتار مغناطیسی پوششها از دستگاه مغناطیس سنج نمونه لرزان (مغناطیس دقیق کویر کاشان) استفاده شد. برای این



شکل ۱- بازده محلول بر حسب چگالی جریان آبکاری برای هر دو حمام مورد استفاده در این تحقیق

یکی از مکانیزمهای اساسی برای رسوب تنگستن، تشکیل کمپلکسهای مختلط درون محلول است. یون آزاد تنگستن یا کمپلکس تنگستن- سیترات نمیتواند به صورت فلز تنگستن احیاء شود و احیاء آن تنها از طریق تشکیل کمپلکسهای تنگستن-کبالت (آهن)- سیترات و سپس احیاء این کمپلکسهای سهتایی صورت میگیرد[۱۷]. بهعبارت دیگر تشکیل کمپلکسهای سهتایی برای رسوب تنگستن الزامی است، در حالیکه فلزات همگروه آهن علاوه بر احیاء از طریق کمپلکسهای

سه تایی، از طریق تشکیل کمپلکسهای دوتایی شامل سیترات یا آمونیا نیز قابلیت رسوبدهی دارند[۱۷]. بنابراین مسیرهای بیشتری برای رسوب آنها نسبت به تنگستن پیشنهاد شده است. از آنجا که احیاء کمپلکسهای سه تایی به مراتب مشکلتر از کمپلکسهای دوتایی است میتوان پیشبینی کرد که با افزایش یون

ترکیب شیمیایی آلیاژ رسوب کرده در شرایط مختلف آبکاری در جدول ۲ و ۳ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که با افزایش چگالی جریان، مقدار تنگستن رسوب کرده کاهش مییابد. چگالی جریانهای کم واکنش تحت کنترل اکتیواسیون است در حالی که با افزایش چگالی جریان واکنش تحت کنترل نفوذ بوده و چون غلظت اجزاء فعال الکتروشیمیایی (حاوی عنصر تنگستن) در این ناحیه کمتر بوده و تشکیل این اجزاء نسبت به بقیه کمپلکسها مشکل تر است، نفوذ این اجزاء به سمت کاتد و در نتیجه احیاء تنگستن دشوارتر خواهد بود [۸۸]. از آنجا که مقدار یون تنگستن در حمام ۲۰/۰ مولار یون تنگستات بیشتر است، شرایط برای احیاء یون تنگستن مناسبتر از حمام ۲۰/۰ مولار بوده و طبیعتاً مقدار تنگستن رسوب کرده، افزایش مییابد.

جدول ۲- ترکیب شیمیایی، اندازه دانه و فازهای مربوط به پوششهای حاصل از حمام ۰/۰۱ مولار یون تنگستات و در چگالی جریانهای مختلف آبکاری

فازها	اندازه دانه	W	Со	Fe	چگالی جریان
	(nm)	(wt. %)	(wt. %)	(wt. %)	(mA/cm ²)
fcc+bcc	18	١٨	۲٩	۵۲	١.
bcc	١٢))	۳۸	۵۰	۲.
bcc	١٣	١.	٣۴	۵۴	۳۵
bcc	١٩	١.	٣١	۵۸	۵۰

ام زاغ	اندازه دانه	W	Со	Fe	چگالی جریان
فارها	(nm)	(wt. %)	(wt. %)	(wt. %)	(mA/cm^2)
fcc+bcc))	۲۵	٣٧	۳۶	١.
fcc+bcc	١٢	١٨	٣٢	۴٩	۲۰
fcc+bcc	11	١٩	٣٧	۴۲	۳۵
bcc	۱.	١۴	٣٩	48	۵۰

جدول ۳- ترکیب شیمیایی، اندازه دانه و فازهای مربوط به پوششهای حاصل از حمام ۰/۰۳ مولار یون تنگستات و در چگالی جریانهای مختلف آبکاری

با توجه به نتایج آنالیز شیمیایی و میزان آهن و کبالت موجود در پوششها، میتوان ادعا کرد که رسوبگذاری به صورت غیر نرمال انجام میشود. در این حالت نسبت فلز فعال به نجیب در پوشش بیشتر از این نسبت در الکترولیت میشود[۱۱،۱۹،۲۰]. مکانیزمهای گوناگونی برای توضیح این پدیده وجود دارد. بر طبق نظر برینر و برای توضیح این پدیده وجود دارد. بر طبق نظر برینر و رسوبگذاری عادی میشود[۹]. با افزایش چگالی جریان، شرایط برای احیاء هیدروژن مناسبتر شده و با مصرف شرایط برای احیاء هیدروژن مناسبتر شده و با مصرف به جذب هیدروکسید آهن به مراتب بیشتر از هیدروکسید به جذب هیدروکسید آهن به مراتب بیشتر از هیدروکسید کرده قابل پیش بینی است.

شکل ۲، تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی پوششها را در حمامهای مختلف و نیز چگالی جریانهای متفاوت نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده پوششهای حاصل از دو حمام مورفولوژی متفاوتی دارند، بهعبارت دیگر مورفولوژی سطح پوششهای حاصل از حمام ۲۰۱۱ مولار یون تنگستات گل کلمی بوده در حالی که پوششهای حاصل از حمام ۲۰۱۳ مولار یون تنگستات مورفولوژی گنبدی شکل دارند که با افزایش چگالی جریان تعداد برآمدگیها و ترکهای سطحی نیز افزایش مییابد.

حضور ترکهای سطحی، ناشی از افزایش تنش در پوشش است. این تنشها منشاء گوناگونی دارند، حضور اتمهای حل شده بزرگتر در زمینه اصلی، افزایش ضخامت فیلم، کاهش اندازه دانهها و نیز احیاء شدید هیدروژن از جمله عوامل اصلی ایجاد تنش هستند [۲۳–۲۱، ۱۱].

اگرچه با افزایش چگالی جریان، شرایط برای آزادسازی هیدروژن مناسبتر بوده[۱۶] و این خود عامل اصلی ایجاد تنش در پوشش است؛ اما حضور مقادیر بیشتر تنگستن در آلیاژ رسوبکرده و نیز کاهش بیشتر اندازه دانهها منجر به ایجاد ترک در پوششهای حاصل از حمام ۲۰/۳ مولار یون تنگستات نسبت به حمام ۲۰/۱ مولار شده است.

مطالعات فازي

الگوی پراش اشعه ایکس پوشش های حاصل از دو حمام مختلف در چگالی جریان های متفاوت در شکل ۳ آورده شده است. با توجه به الگوهای حاصل و نیز نتایج مربوط به EDS پوشش ها، زمینه اصلی آلیاژ مربوط به آهن با ساختار bcc است (شماره کارت ۰۱–۰۸۷–۲۷۲۰) که عناصر کبالت و تنگستن در شبکه آن حل شدهاند. با توجه به جدول ۲ و ۳ حضور مقادیر قابل توجه کبالت و تنگستن تایید شده است؛ اما طبق نتایج پراش اشعه ایکس هیچ اثری از حضور تنگستن دیده نمی شود. دلیل این امر انحلال تنگستن در شبکه آهن و تشکیل محلول جامد پیش بینی شده است.



شکل ۲- تصاویر SEM مربوط به پوششهای بدست آمده از دو حمام مختلف، ستون سمت راست مربوط به حمام ۰۱/۰ و ستون سمت چپ مربوط به حمام ۰/۰۳ مولار یون تنگستات در چگالی جریانهای (الف، ه) ۱۰ (ب، و) ۲۰، (ج، ز) ۳۵ و (د، ی) ۵۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع

شده و این امر سبب افزایش حد حلالیت کبالت در ساختار آهن می شود. بنابراین علیرغم حضور مقادیر بیش تر کبالت در چگالی جریان های بالاتر، ساختار از حالت دوفازی به حالت تک فازی bcc تبدیل می شود. این مطلب در مورد پوشش های حاصل از حمام ۰/۰۳ مولاریون تنگستات نیز صادق است (شکل ۳ ب). در چگالی جریان ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع که مقدار تنگستن پوشش بیشینه است (جدول ۲)، حد حلالیت کبالت در زمینه آهن کاهش یافته و در نتیجه مقداری از آن به صورت ذرات فاز دوم (کبالت fcc) در ساختار bcc رسوب می کند (شکل ۳ الف). افزایش در چگالی جریان منجر به کاهش مقدار تنگستن رسوب کرده





شکل ۳- الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به پوششهای حاصل از حمامهای الف) ۰/۰۱ و ب) ۰/۰۳ مولار یون تنگستات

به این صورت که با افزایش چگالی جریان (کاهش تنگستن) از شدت پیکهای مربوط به صفحات (۱۱۱) و (۲۰۰) کبالت کاسته شده و در بالاترین چگالی جریان آبکاری ساختار به صورت محلول جامد تک فاز آهن با ساختار bcc ظاهر می شود.

روند تغییرات اندازه دانه این پوششها در چگالی جریانهای مختلف برای هر دو محلول در جدول ۲ و ۳ آورده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده ملاحظه میشود که در تمامی حالات اندازه دانهها کمتر از ۲۰

نانومتر بوده و تغییرات چشمگیری در اندازه دانهها مشاهده نمیشود.

در اینجا باید اشاره کرد که فرایند انتقال بار در چند مرحله پیش می رود. انتقال یونها از لایه دوگانه الکتریکی به محلهای آزاد و جذب آنها، نفوذ سطحی یونهای جذب سطحی شده به سمت پلهها^۱ و در نهایت انتقال یونها از پلهها به لبهها^۲ [۲۴].

¹-Steps

²- Edge

افزایش چگالی جریان (فراپتانسیل) سبب افزایش نفوذ سطحی یونها شده و باعث انتقال سریعتر اتمها به سمت مراکز فعال رشد (پلهها و لبهها) و در نتیجه تسهیل در رشد دانهها میشود. از طرف دیگر سد انرژی جوانه زنی به طور معکوس با مربع فراپتانسیل رابطه دارد. با افزایش چگالی جریان و در نتیجه افزایش فراپتانسیل، سرعت چگالی جریان و در نتیجه افزایش فراپتانسیل، سرعت مد[۲۲، ۲۴، ۲۵]. با توجه به مطالب اخیر میتوان نتیجه شد[۵۲ ۲۴، ۲۴]. با توجه به مطالب اخیر میتوان نتیجه دانه در پوشش است. در اینجا این دو عامل تاثیر یکسانی داشته و اثر یکدیگر را از بین میبرند؛ بنابراین تغییرات چشمگیری در اندازه دانهها مشاهده نمیشود.

ارزيابي رفتار مغناطيسي

نمودارهیسترزیس پوششهای حاصل از حمامهای با ترکیب شیمیایی متفاوت و در چگالی جریانهای مختلف در شکل ۴ آورده شده است. جدول ۴ نیز اطلاعات استخراج شده از نمودار هیسترزیس را بصورت خلاصه نشان می دهد.

بزرگی میدانی که لازم است اعمال شود تا مغناطش پسماند در ماده را به صفر برساند، میدان پسماندزدا یا اصطلاحاً وادارندگی نامیده میشود [۲۶]. بر خلاف مغناطش اشباع که یک کمیت ذاتی بوده و عمدتاً تابع ترکیب شیمیایی ماده است، وادارندگی یک کمیت غیر ذاتی است و متاثر از پارامترهای گوناگونی میباشد. نوع فازها، ترکیب شیمیایی و نیز اندازه دانهها تاثیر مستقیمی بر رفتار مغناطیسی در ماده دارند [۱۲،۲۵].

با توجه به نتایج ارائه شده، ملاحظه می شود که تمامی پوشش ها خاصیت مغناطیسی نرم داشته (وادارندگی کم تر از ۲۰۰ اورستد) و افزایش چگالی جریان منجر به تغییر در مغناطش اشباع آلیاژ می شود. در این مورد یک اتفاق نظر وجود دارد و آن این است که کاهش در مقدار عنصر غیرمغناطیسی منجر به افزایش در مغناطش اشباع

می شود [۱۱]. در مورد پوششهای به دست آمده نیز این نتيجه صادق است. از آنجا كه تنگستن عنصرى غیرمغناطیسی است، افزایش چگالی جریان منجر به کاهش مقدار تنگستن و در نتیجه افزایش در مغناطش اشباع آلیاژ می شود. با توجه به اینکه آهن دارای بالاترین مقدار مغناطش اشباع در بین عناصر هم گروه خود است، تغییرات آن نیز اثر مستقیم بر روی مغناطش اشباع خواهد داشت. از آنجا که مقدار تنگستن رسوب کرده از حمام ۰/۰۱ مولار یون تنگستات پس از رسیدن به چگالی جریان ۲۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع تقریباً ثابت است؛ لذا تغییر در مغناطش اشباع آلیاژ را می توان منطبق با مقدار آهن رسوب کرده مربوط دانست. در مورد پوششهای به دست آمده از حمام ۰/۰۳ مولار یون تنگستات نیز افزایش چشمگیری در مقدار مغناطش اشباع در چگالی جریان ۲۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع دیده میشود که ناشی از تاثیر همزمان آهن و تنگستن است.

باید اشاره کرد که مغناطیسی شدن ماده طی چندین مرحله اتفاق میافتد. قبل از اعمال میدان، نمونه از تعدادی حوزه مغناطیسی تشکیل شده است و در کل ماده دارای گشتاور مغناطیسی صفر میباشد. در این حالت جهت بردار برآیند در حوزههای مغناطیسی در جهت خاصی است. در واقع هر ماده متناسب با ساختار شدن خود به خودی حوزهها قبل از اعمال میدان، متناسب با این جهتها اتفاق میافتد. به عنوان مثال این جهات در فلزات با ساختار کریستالی fcc و sod به ترتیب <۰۰۱ فلزات با ساختار کریستالی مدان مغناطیسی در مرحله و <۰۱۱> میباشند. با اعمال میدان مغناطیسی در مرحله اول، حوزههایی که بردار برآیند ممانهای مغناطیسی آنها ماده به یک تک حوزه مغناطیسی تبدیل میشود و در ادامه چرخش حوزههای مغناطیسی صورت میگیرد [۲۷].





شکل ۴- نمودار هیسترزیس مربوط به پوششهای حاصل از حمامهای الف) ۰/۰۱ و ب) ۰/۰۳ مولار یون تنگستات

با توجه به شکل ۴ ملاحظه می شود که سرعت رسیدن به حالت اشباع مغناطیسی (شیب نمودارها در ناحیه خطی) در مورد پوشش های حاصل از حمام ۰/۰۱ مولار یون تنگستات بیش تر از حمام دیگر است. بهنظر می رسد که جهت آسان مغناطش در این پوشش ها نزدیک تر به جهت

میدان اعمالی است و این سبب سهولت در رشد حوزهها، چرخش ممانها در جهت میدان اعمالی و نهایتاً تسریع در رسیدن به حالت اشباع مغناطیسی می شود.

۰/۰۳ مولار	محلول '	۰/۰۱ مولار	محلول	
M _s	H _c	M_{e} (emu/cm ²)	H _c	(mA/cm²)حگالی جریان
(emu/cm ²)	(Oe)		(Oe)	
• /AA	14/99	•/۵۲	۱۵/۵۸	۱.
1/48	8/47	•/٩٢	11/1	۲۰
١/•٣	۵٩/١٣	1/11	17/18	۳۵
١/٢٨	VV/ F V	١/٤۵	۲•/٩•	۵۰

جدول ۴- مغناطش اشباع و وادارندگی پوششهای به دست آمده از حمامهای ۰/۰۱ و ۰/۰۳ مولار یون تنگستات و در چگالی جریانهای مختلف آبکاری

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر کنترل مقدار وادارندگی اندازه دانه است. کاهش در اندازه دانه مطابق با رابطه (۳) منجر به کاهش در وادارندگی مغناطیسی میشود [۲۹ ۴٬۲۸٬]:

$$H_{c} = P_{c} \frac{k_{1}^{4}}{J_{s} A^{2}} D^{6} \tag{(7)}$$

در این رابطه Hc وادارندگی، Dاندازه دانه، A ثابت تبادل، k1 انرژی ناهمسانگردی مگنتوکریستالی، Js گشتاور مغناطیسی و pc مقداری ثابت است. با کاهش اندازه دانه به مقادیر کمتر از طول تبادلی، تاثیر برهمکنشهای تبادلی بر اثر نامطلوب مرز دانه غلبه کرده و این امر منجر به همسو شدن گشتاورهای مغناطیسی و بنابراین کاهش در وادارندگی می شود [۳۰]. برای هر ماده مغناطیسی، بعدی به نام طول همسو گردانی یا طول تبادلی در نظر گرفته که با رابطه (۴) داده می شود [۳۱]:

$$L_{ex} = \sqrt{\frac{A}{k_1}} \tag{(f)}$$

اگر اندازه دانه بزرگتر از طول تبادلی باشد، کاهش در اندازه دانه مطابق با رابطه (۵) سبب افزایش در مقدار وادارندگی میشود [۴، ۲۸، ۲۹]:

$$Hc \sim 3 \sqrt{\frac{KT_{c}k_{1}}{aM_{s}}} \frac{1}{D}$$
 (Δ)

K مغناطش اشباع، T_c در این رابطه M_s مغناطش اشباع، T_c دمای کوری، t_s ثابت بولتزمن و a پارامتر شبکه است.

با توجه به مباحث اخیر، علیرغم ثابت بودن اندازه دانهها، مقدار وادارندگی مربوط به پوششهای حاصل از حمام ۲۰/۳ مولار یون تنگستات در محدوده نسبتاً وسیعی قرار دارد (جدول ۴). بهعبارت دیگر، مقدار H_c در آلیاژ افزایش یافته و در چگالی جریان ۵۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع به حداکثر مقدار خود میرسد (OP VP). همان گونه که قبلاً ذکر شد، با افزایش چگالی جریان مقدار فاز bcc افزایش و مقدار فاز fcc کاهش یافت محققین، ناهمسانگردی مغناطیسی در فاز fcc کمتر از محققین، ناهمسانگردی مغناطیسی در فاز fcc کمتر از محققین، ناهمسانگردی مغناطیسی در ماده میشود [1]. با

توجه به مطالب ذکر شده، میتوان تغییرات گسترده در مقدار وادارندگی (۷۷– ۱۵ اورستد) را به تغییرات فازی در این پوششها مربوط دانست.

روند تغییرات وادارندگی مربوط به پوششهای حاصل از حمام ۰/۰۱ مولار یون تنگستات به گونه دیگری است. در اینجا نیز اندازه دانهها تقریباً ثابت بوده و تغییرات وادارندگی منطبق با اندازه دانهها عمل می کند.

ميكروسختي پوششها

شکل ۵، میکروسختی پوششها را برحسب چگالی جریان و ترکیب شیمیایی محلول نشان میدهد. در حالت کلی میکروسختی، با ایجاد محلولهای جامد افزایش مییابد که دلیل آن کاهش در تحرک نابجاییها گزارش

شده است [۳۲]. از طرفی مطابق با رابطه هال-پچ می توان مقدار سختی را با کاهش در اندازه دانهها افزایش داد [۳۳]:

$$H = H_0 + kd^{-0.5}$$
 (8)

در اینجا H_0 و k ثوابت مربوط به سختی و h اندازه دانه است که با رابطه شرر قابل محاسبه است. با توجه به شکل ۵ ملاحظه میشود که با افزایش چگالی جریان میکروسختی پوششها کاهش مییابد که دلیل آن کاهش درصد تنگستن گزارش شده است. از آنجا که مقدار تنگستن رسوب کرده از حمام ۲۰/۰۳ مولار یون تنگستات بیش تر از حمام دیگر است؛ بنابراین میتوان میکروسختی بالاتر در این دسته از پوششها را توجیه کرد.



چگالی جریان (میلی آمپر بر سانتیمتر مربع)

شکل ۵- میکروسختی پوششها بر حسب چگالی جریان آبکاری

نتيجه گيري

در این پژوهش به بررسی اثر چگالی جریان آبکاری و نیز ترکیب شیمیایی محلول بر خواص مغناطیسی و ساختاری ماده پرداخته شد. نتایج نشان داد که مورفولوژی پوششها تحت تاثیر ترکیب شیمیایی و چگالی جریان آبکاری بوده و با افزایش مقدار یون تنگستات در محلول مورفولوژی پوششها از حالت گل کلمی به حالت گنبدی شکل تغییر یافت. علاوه بر این علت ایجاد ترک بر سطح پوششهای حاصل از حمام ۰/۰۳ مولار یون تنگستات احیاء شدید هیدروژن در چگالی جریانهای بالاتر شناخته شد.

از آنجا که با افزایش چگالی جریان آبکاری در حمام ۰/۰۳ مولار یون تنگستات مقدار فاز fcc در پوششهای مربوطه کاهش یافت میتوان تغییرات وادارندگی را به تغییرات فازی در این پوششها مربوط دانست. در مورد powder", Materials and Design, Vol. 36, pp. 35–40, 2012.

- 5- N. M. Nik Rozlin and A. M. Alfantazi, "Nanocrystalline cobaltiron alloy: Synthesis and characterization", Materials Science and Engineering A, Vol. 550, pp. 388-394, 2012.
- 6- A. Karpuz, H. Kockar, M. Alper, O. Karaagac and M. Haciismailoglu, "Electrodeposited Ni–Co films from electrolytes with different Co contents", Applied Surface Science, Vol. 258, pp. 4005–4010, 2012.
- 7- J. A. Koza, F. Karnbach, M. Uhlemann, J. McCord, C. Mickel, A. Gebert, S. Baunack and L. Schultz, "Electrocrystallisation of CoFe alloys under the influence of external homogeneous magnetic fields— Properties of deposited thin films", Electrochimica Acta, Vol. 55, pp. 819–831, 2010.

پوششهای بدست آمده از محلول ۰/۰۱ مولار یون تنگستات شرایط به گونه دیگر است. در این جا وادارندگی تقریباً ثابت بوده و منطبق با اندازه دانهها عمل می کند.

با افزایش چگالی جریان میکروسختی پوششها کاهش یافت که علت آن کاهش درصد تنگستن رسوب کرده میباشد. از آنجا که مقدار تنگستن رسوب کرده در حمام ۰/۰۳ مولار یون تنگستات بیشتر از حمام دیگر است بنابراین میتوان میکروسختی بالاتر در این دسته از پوششها را توجیه کرد.

تشكر و قدرداني

از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) بخاطر حمایت مالی در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی می شود.

References:

- G.P. Pavithra and A. Chitharanjan Hegde, "Magnetic property and corrosion resistance of electrodeposited nanocrystalline iron– nickel alloys", Applied Surface Science, Vol. 258, pp. 6884–6890, 2012.
- 2- S. Mehrizi, M. Heydarzadeh Sohi and S.A. Seyyed Ebrahimi, "Study of microstructure and magnetic properties of electrodeposited nanocrystalline CoFeNiCu thinfilms", Surface & Coatings Technology, Vol. 205, pp. 4757–4763, 2011.
- 3- A. Karpuz, H. Kockar and M. Alper, "Effect of film thickness on properties of electrodeposited Ni–Co films", Applied Surface Science, Vol. 258, pp. 5046–5051, 2012.
- 4- A. Sharifati and S. Sharafi, "Structure and magnetic properties of mechanically alloyed (Fe₇₀Co₃₀)₉₁Cu₉

- 8- J. A. Koza, M. Uhlemann, A. Gebert and L. Schultz, "The effect of magnetic fields on the electrodeposition of CoFe alloys", Electrochimica Acta, Vol. 53, pp. 5344–5353, 2008.
- 9- C. Qiang, J. Xu, S. Xiao, Y. Jiao, Z. Zhang, Y. Liu, L. Tian and Z. Zhou, "The influence of pH and bath composition on the properties of Fe– Co alloy film electrodeposition", Applied Surface Science, Vol. 257, pp. 1371–1376, 2010.
- 10- H. Kockar, E. Ozergin, O. Karaagac and M. Alper, "Characterisations of CoFeCu films: Influence of Fe concentration", Journal of Alloys and Compounds Vol. 586, pp. 326–330, 2014.
- 11-A.M.P. Sakita, E.C. Passamani, H. Kumar, D.R. Cornejo, C.S. Fugivara, R.D. Noce and A.V. Benedetti, "Influence of current density on crystalline structure and magnetic properties of electrodeposited Co-rich CoNiW alloys", Materials Chemistry and Physics Vol. 141, pp. 576–581, 2013.
- 12- N. Tsyntsaru, H. Cesiulis, E. Pellicer, J.-P. Celis and J. Sort, "Structural, magnetic, and mechanical properties of electrodeposited cobalt–tungsten alloys: Intrinsic and extrinsic interdependencies", Electrochimica Acta, Vol. 104, pp. 94–103, 2013.
- 13- A. L. M. Oliveira, J. D. Costa, M. B. de Sousa, J. J. N. Alves, A. R. N. Campos, R. A. C. Santana and S. Prasad, "Studies on electrodeposition and characterization of the Ni–W–Fe alloys coatings", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 619, pp. 697–703, 2015.

- 14-B. Cullity, S. R Stock and S. Stock, Elements of x-ray diffraction, Addision-Wesley, London, 2001.
- 15-M.A. Farzaneh, K. Raeissi and M.A. Golozar, "Effect of current density on deposition process and properties of nanocrystalline Ni–Co–W alloy coatings", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 489, pp. 488–492, 2010.
- 16-M.A. Farzaneh, M.R. Zamanzad-Ghavidel, K. Raeissi, M.A. Golozar, A. Saatchi and S. Kabi, "Effects of Co and W alloying elements on the electrodeposition aspects and properties of nanocrystalline Ni alloy coatings"Applied Surface Science, Vol. 257, pp. 5919–5926, 2011.
- 17-O. Younes, L. Rosenberg, Y. Shacham-Diamand and E. Gileadi, "Electroplating of Amorphous Thin Films of Tungsten/ Nickel Alloys", Langmuir, Vol. 17, pp. 8270–8275, 2001.
- 18- M.D. Obradovic, R.M. Stevanovic and A.R. Despic, "Electrochemical deposition of Ni-W alloys from ammonia-citrate electrolyte", Journal of Electroanal. Chemistry, Vol. 552, pp. 185–196, 2003.
- 19- R. Oriňáková, A. Oriňák, G. Vering, I. Talian, R. M. Smith and H. F. Arlinghaus, "Influence of pH on the electrolytic deposition of Ni–Co films", Thin Solid Films, Vol. 516, pp. 3045-3050, 2008.
- 20- A. Karpuz, H. Kockar, M. Alper, O. Karaagac and M. Haciismailoglu, "Electrodeposited Ni–Co films from electrolytes with different Co contents", Applied Surface Science, Vol. 258, pp. 4005-4010, 2012.

- 21-I. Shao, L.T. Romankiw and C. Bonhote, "Stress in electrodeposited CoFe alloy films", Journal of Crystal Growth, Vol. 312, pp. 1262–1266, 2010.
- 22-Z. Ghaferi, K. Raeissi, M.A. Golozar and H. Edris, "Characterization of nanocrystalline Co–W coatings on Cu substrate, electrodeposited from a citrate-ammonia bath", Surface & Coatings Technology, Vol. 206, pp. 497–505, 2011.
- 23- R.A.C. Santana, S. Prasad, A.R.N. Campos, F.O. Araujo, G.P. Da Silva and Ρ. De Lima-Neto, "Electrodeposition and corrosion behaviour of a Ni-W-B amorphous alloy", Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 36, pp. 105-113, 2006.
- 24-Sh. Hassani, K. Raeissi and M. A. Golozar, "Effects of saccharin on the electrodeposition of Ni–Co nanocrystalline coatings", Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 38, pp. 689–694, 2008.
- 25-L. Tian, J. Xu and S. Xiao, "The influence of pH and bath composition on the properties of Ni–Co coatings synthesized by electrodeposition", Vacuum, Vol. 86, pp. 27–33, 2011.
- 26-J. F. Rohan, B. M. Ahern, K. Reynolds, S. Crowley, D. A. Healyb, F. M.F. Rhen and S. Roy, "Electroless thin film CoNiFe–B alloys for integrated magnetics on Si", Electrochimica Acta, Vol. 54, pp. 1851–1856, 2009.
- 27-B. D. Cullity, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Addisson Wesley, Boston, 1972.

- 28-A. H. Bahrami, S. Sharafi and H. Ahmadian Baghbaderani, "The effect of Si addition on the microstructure and magnetic properties of permalloy prepared by mechanical alloying method", Advanced Powder Technology, Vol. 24, pp. 235–241, 2013.
- 29-M. Khajepour and S. Sharafi, "Structural and magnetic properties of nanostructured Fe₅₀(Co₅₀)–6.5 wt% Si powder prepared by high energy ball milling", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 509, pp. 7729– 7737, 2011.
- 30- B. Zuo, N. Saraswati, T. Sritharan and H.H. Hng, "Production and annealing of nanocrystalline Fe–Si and Fe–Si– Al alloy powders", Materials Science and Engineering A, Vol. 371, pp. 210–216, 2004.
- 31-Z. Ghaferia, S. Sharafi, M.E. Bahrololoom, "Effect of current density and bath composition on crystalline structure and magnetic properties of electrodeposited FeCoW alloy", Applied Surface Science, Vol. 355, pp. 766–773, 2015.
- 32- F. He, J. Yang, T. Lei and C. Gu, "Structure and properties of electrodeposited Fe–Ni–W alloys with different levels of tungsten content: A comparative study", Applied Surface Science, Vol. 253, pp. 7591–7598, 2007.
- 33-F. H. Su and P. Huang, "Microstructure and tribological property of nanocrystalline Co-W alloy coating produced by dual-pulse electrodeposition", Materials Chemistry and Physics, Vol. 134, pp. 350-359, 2012.